## 电子科技大学 2016 年攻读硕士学位研究生入学考试试题 考试科目: 818 固体物理

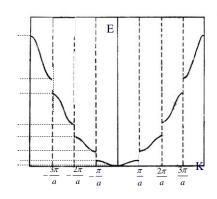
注: 所有答案必须写在答题纸上,写在试卷或草稿纸上均无效。

一、填空题(共 30 分,每空 1 分)
1、半导体材料 Si 具有金刚石型晶体结构,晶格常数为 a,布喇菲格子是;一个惯
用元胞(结晶学元胞)内的原子数②,其配位数为③。惯用元胞体积为
学格波的支数为
2、晶体宏观对称操作中包含 ① 、 ② 、 ③ 、 ④ 、 ⑤ 、
<u>⑥ 、 ⑦ 、 ⑧ </u> 共8种独立基本对称操作元素。
3、假设有某一维复式格子,其每个固体物理学原胞中含有 2 个原子,整个晶体共有 N 个固体
物理学原胞,整个晶体共有 2N 个原子,晶体的自由度数为 2N,则对于这样一种二维复式格
子的晶格振动, (1). 共存在 <u>①</u> 支独立的格波; (2). 有意义的波矢 $ec{q}$ 的取值个数
为
4、螺位错线与滑移矢量之间的方向关系是, 刃型位错线与滑移矢量之间的方向关
系是。
5、电子在三维周期性晶格中波函数方程的解具有
下保持不变。
6、金属电子论中,金属晶体中自由电子遵从 <u>①</u> ,其占据能量 E 的几率函数为
为
7、在边长为 L 的立方金属中,自由电子的能量可以用一组量子数表示为①。
8、晶体的第 $n$ 个禁带宽度 $E_g$ 为。

## 二、简答题(共60分,每题10分)

$$\frac{c}{1} = (\frac{8}{3})^{\frac{1}{2}} \doteq 1.633$$
 1、作图证明六方密堆积结构中, $\frac{c}{a} = (\frac{8}{3})^{\frac{1}{2}} \doteq 1.633$ 

- 2、在立方晶胞中、作图指出(111)面与(100)面交线的晶向。
- 3、通过不同的结合力原子结合成晶体,试分析离子结合和共价结合的特点。
- 4、简述声子的概念和性质。
- 5、在近自由电子近似中,某晶体中电子的 E~K 关系广延图如下,简述晶体能带结构的特点?



6、简述电子有效质量为负值的物理解释?

## 三、计算题(共60分,第1题10分,第2、3题15分,第4题20分)

1、(10 分) 利用晶面面间距  $d_{hkl}$ 与倒格矢  $K_{hkl}$ 的关系  $d_{hkl} = \frac{2\pi}{\left|\vec{K}_{hkl}\right|}$ , 求晶格常数为 a 的面心立

方晶面族  $(h_1 \ h_2 \ h_3)$  的面间距。

- 2、(15分)证明在极低温度下,一维单式晶格的热容正比于T。
- 3、(15 分)利用布洛赫定理 $\psi(\vec{r}+\vec{R}_n)=e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}_n}\psi(\vec{r})$ 的形式,针对一维周期势场中电子波函数:

(1) 
$$\psi_k(x) = \sin \frac{x}{a} \pi$$
; (2)  $\psi_k(x) = i \cos \frac{3x}{a} \pi$ ; (3)  $\psi_k(x) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} f(x-la)$ 。 求电子在这

些状态的波矢。

- 4、(20 分)对于边长为本 a 的二维正方格子,求(1)其倒格子原胞基矢及前两阶布里渊区;
- (2)应用紧束缚近似求出 s 态电子的能量表达式; (3)求出电子的速度; (4)求出带底电子

的有效质量及带顶空穴的有效质量。(注: 
$$E(\vec{k}) = E_0 - C_s - J_0 \sum_{\vec{k}}^{\text{最近邻}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{k}_n}$$
)